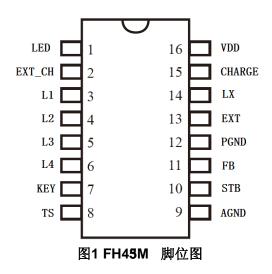
HONGTEK

FH453M 应用指导

一、概要:

FH453M是一款集成了充电管理模块、电量检测及 LED 指示模块、升压放电管理模块,完全取代目前市场上的充电管理 IC+MCU+升压 IC 方案。

二、脚位图及说明



序号 名称 描述 50mA LED驱动(手电筒功能) 1 LED 2 EXT CH 充电外扩控制脚 3 电池电量指示LED1 L1 4 电池电量指示LED 2 L2 5 L3 电池电量指示LED 3 6 L4 电池电量指示LED 4 7 KEY 功能按键 8 TS 测试模式功能脚 9 **AGND** 信号地 10 STB 外部待机 MOS 使能信号 11 FΒ 电压反馈脚 12 **PGND** 功率地 13 升压电路外扩驱动 **EXT** 14 LX 升压电路内部功率管输出 15 **CHARGE** 充电输出,接电池正极 VDD 16 功率电源正极

表 1 FH453M 各个脚位描述

三、典型应用电路:

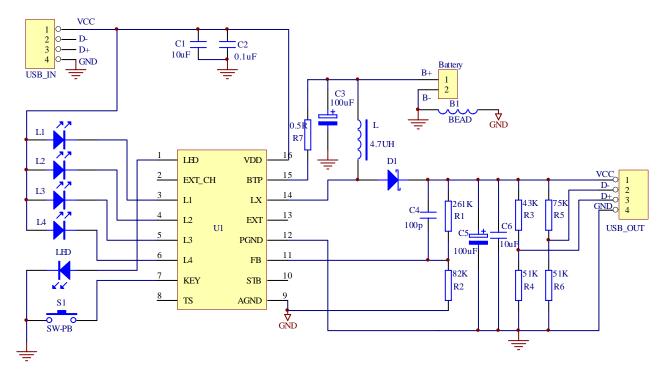


图 2.内置 MOSFET 应用图

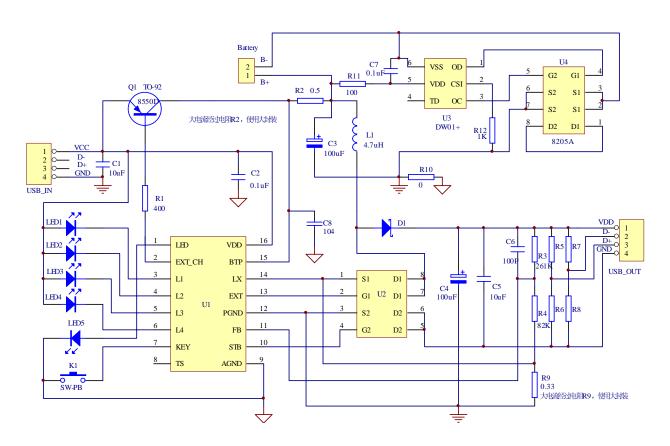
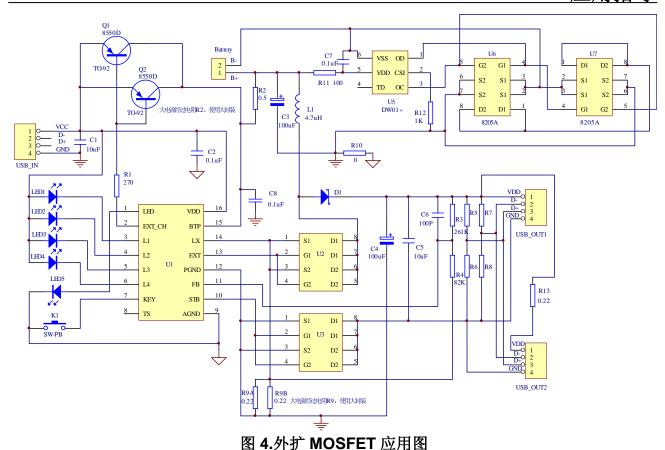


图 3.外扩 MOSFET 应用图



四、功能介绍:

◆ 充电

当 USB_IN 接入 5V 电源时,FH453M进入充电状态,此时升压输出关闭,指示灯 L1~L4 做浪涌式充电指示(详细显示模式请参考规格书),使用内置 MOSFET 充电时最大充电流为 500mA,可参考图 2应用原理进行设计,如需要更大的充电电流可按照图 3 连接原理将管脚 2 处的充电外扩电路连上,Q1 按照所需的电流进行选用不同的三极管,并调整 R1 阻值达到所需要的充电电流值。

◆ 升压输出

在待机状态时,短按按键 S1(时间>50mS),当 7 脚 KEY 检测到输入低电平脉冲信号时从待机状态唤醒,同时启动升压输出;此输出电压值可通过公式 Vout=1.25V×(R3/R4+1)进行调整 R3、R4 的电阻值得到所需的电压,在电池电压欠压(3.3V)或进入限流/短路保护时关闭升压输出,进入待机模式。升压电路内部集成了 MOSFET,根据所接外部设备的不同时放电电流为 300~500mA,如需更大的放电电流可按照图 3 原理在 U2 位置选用不同规格的 N 沟道 MOSFET,这样便可以满足 iphone、ipad 等设备充电需要;另外在对 iphone、ipad 设备进行充电时还应该满足 USB 接口的 D-、D+信号线的电压要求,可设(D-)=2.0V,(D+)=2.7V。

◆ 电量检测

当 7 脚(KEY)检测到输入低电平脉冲信号时,对内置电池电量检测;并通过 L1~L4 对电量显示,电量显示 3~5S 后关闭;

◆ LED 手电照明

只要在 0.5S 内连续按按键 S1 两下,打开 LED 手电照明功能;同样再连续按 S1 按键两下即可关闭

LED 手电照明。

◆ 待机模式:

- 1、长按按键 S1 (大于 3S) 进入待机模式
- 2、智能检测没有充电输入、没有放电输出(<100mA)、没有打开 LED 手电 3 分钟内进入待机模式
- 3、 待机功耗可控制在 30uA 内

在待机时 FH453M通过第 10 脚(STB)控制 U3 处的 N 沟道 MOSFET 将升压输出回路完全断开,此 MOSFET 的选型也要根据所需的放电电流进行选择。

五、注意事项(以图3为例):

PCBLAYOUT:

- 1. C1、C2 尽量靠近 VDD 脚, C3 尽量靠近 CHARGE 脚,并且走线时都经过电容再到 IC 管脚。
- 2. 连接分压电阻 R3、R4 的线尽量短,不要太粗,并远离电感等器件
- 3. AGND →和 PGND → 必须分开走线,最后在 C3 负极一点接地; AGND 到 C3 的线不要太粗,远离电感等器件,PGND 尽量粗短,有必要需要做露铜处理。
- 4. 连到 IC CHARGE 脚和 L1 脚的走线需经 C3 正极后分开走线。
- 5. 功率环路面积尽量小。

元器件选择:

1. 升压电路输出电容的选择。

输出电容的选择决定于输出电压纹波。在大多数场合,要使用低 ESR 电容,如陶瓷和聚合物电解电容。如果使用高 ESR 电容,就需要仔细查看转换器频率补偿,并且在输出电路端可能需要加一额外电容。

2. DC-DC 升压电路电感材质值的选择。

因为电感值影响输入和输出纹波电压和电流,所以电感的选择是感性电压转换器设计的关键。等效串联电阻值低的电感,其功率转换效率最佳。要对电感饱和电流额定值进行选择,使其大于电路的稳态电感电流峰值。

- 3. 升压转换器要选快速正向压降低的肖特基整流二极管。使其功耗低并且效率高。肖特基二极管平均电流额定值应大于电路最大输出电流。
- 4. MOSFET N尽量选用内阻小,开关速度快的,使其功耗低并且效率高,并且做好散热处理。